



報道関係者各位

Soitec 問合せ先:

Camille Darnaud-Dufour
Vice President, Communications

Soitec

Mobile (U.S.): +1-650-796-0634
Mobile (France): +33-06-79-49-51-43
E-mail: camille.darnaud-dufour@soitec.com

代理店問合せ先:

Kelly Picasso
Senior Account Associate
MCA
Tel: +1-650-968-8900, ext. 127
E-mail: kpicasso@mcapr.com

プレスリリース

SOITEC、業界初の歪シリコン・オン・インシュレータ(sSOI)基板の製品化を発表

SEMICON WEST、カリフォルニア州サンフランシスコ発 - 2006年7月11日 - シリコン・オン・インシュレータ(SOI)ウェーハ及びその他の加工基板の世界的な大手サプライヤーである Soitec (Euronext Paris) は、歪シリコン・オン・インシュレータ(sSOI)ウェーハを、65 nm 以降の技術ノード向けに発売することを本日発表しました。これは、次世代基板の業界初の製品化という意味で画期的な出来事です。歪みシリコンのメリットである高電子移動度を SOI のメリットである実証済みの高速及び低電力損失と組み合わせることで、Soitec の sSOI ウェーハは、次世代チップに強力な性能と低消費電力を提供しています。

「この SOI 基板の最新製品は、高速と超低消費電力が重要な課題となっているネットワーク処理、コンピュータ、ゲーム、及びハイエンドの無線産業における最先端アプリケーションをターゲットとしています。半導体メーカーに、彼らの製品の性能と消費電力を更に改善することを可能にするだけでなく、当社の新製品 sSOI ウェーハは将来に向けて拡張可能なプラットフォームを提供するものです」と Soitec の社長兼 CEO である André-Jacques Auberton-Hervé は語っています。

sSOI 技術における Freescale Semiconductor 社の Austin Silicon Technology Solutions 部門の担当役員である Suresh Venkatesan によれば、トランジスタ性能を向上させる一方で動作時と待機時の消費電力の両方を制御する必要性が、半導体産業を創造的で非伝統的なスケールアップ手法の開発に駆り立てています。

Venkatesan は次のように語っています。「歪み SOI 技術は、Freescale がそのトランジスタのロードマップに組み込んでいく技術革新の代表例です。この技術は、現在 45 nm 技術ノード向けに評価中で、最初はネットワークとゲーム用アプリケーションをターゲットとしていますが、最終的には Freescale の顧客が格段に小型で益々強力な娯楽向け電子機器や携帯情報機器を創造するために不可欠となるでしょう」。

sSOI の今後

Soitec は、顧客が電子移動度の驚異的向上とゲートリーク電流と消費電力の低減の両方を求める市場と技術のリーダーから生まれた同社の sSOI 基板の新製品に興味を持っていると報告しています。また、sSOI は、CMOS プロセスに起因する歪み技術に伴うスケールアップ上の問題を克服し、バンドギャップ調整に門戸を開いています。現在、Soitec は、部分空乏型と完全空乏型の両方のアーキテクチャで sSOI 製品を提供しています。既存の SOI 及び CMOS プロセスとの互換性、FinFET 又は Multigate FET 向けに実証された機能、注目すべき高電子移動度、そして次世代への拡張性によって、sSOI は 65 nm 技術ノード以降のデバイスで重要な役割を果たすことは間違いありません。

顧客の新たな sSOI 要求に適合するために、Soitec は同社の 300 mm sSOI プラットフォームを、開発段階から最初の生産段階へと移行させました。これは、市場の要求に従って生産能力を拡張する同社の戦略的計画に

一致するものです。Auberton-Hervé は次のように結論付けています。「SOI でしたように、我々はこの技術を速く採用した顧客の要求を満足させるために初期の生産を立ち上げる予定です。そして、それに続いて、主流となる市場がこの革新的な基板技術に移行し始めた時に量産体制をとることになるでしょう」。

SEMICON West 2006 での記者会見では Freescale Semiconductor 社からゲストスピーカーを予定：
Soitec は、カリフォルニア州サンフランシスコのモスコニー・コンベンション・センターで 7 月 11 日から 13 日まで開催される SEMICON West 2006 において、ブース番号#5425 で展示を予定しています。同社の最新 sSOI 技術の開発についてご興味のある記者の方々は、7 月 11 日火曜日午後 4 時から 6 時にシェラトン・パレス・ホテル(フレンチ・パーラー・ルーム)で開催予定の記者会見に是非お越し下さい。
ご予約は、Kelly Picasso までメール kpicasso@mcapr.com 又は電話+1-650-968-8900 内線 127 に御連絡ください。

Soitec グループについて:

Soitec グループは、Soitec は、今日の最先端電子製品及びナノテクノロジーの基礎となる加工基板の世界有数のイノベーターでありメーカーです。フランスのベルニン(Bernin)に本拠を置く Soitec の SOI 及び歪み SOI (sSOI)を含む加工基板製品群は、既に事実上の業界標準となっている Soitec の特許である Smart Cut™ 技術を使用して製造されています。同社の世界的名声、特許技術、及び業界有数の生産能力によって、Soitec は世界中の消費者が好むよりコンパクトで電力効率が高く携帯性に優れた電子製品に不可欠な性能と低消費電力の実現に貢献しています。株式と 2 つの転換社債は、各々パリ証券取引所が運営するヌーボー・マルシェに上場しています。詳細は、同社のウェブサイト<http://www.soitec.com>を御覧ください。

Smart Cut と UNIBOND は S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies の登録商標です。

###